

[Go to Home Page](#)



For Further Growth Together

フェニテックセミコンダクター株式会社

次世代パワー半導体

キーワード				
次世代パワー半導体	SiC	GaN	MOSFET	ダイオード
ワイドバンドギャップ	Ga203	GaAs	化合物	IGBT

CMOS-IC

キーワード			
1層ポリ	2層メタル	3 μ mルール	0.6 μ mルール
2層ポリ	3層メタル	1.5 μ mルール	0.35 μ mルール
	6層メタル	0.8 μ mルール	0.18 μ mルール

アナログ バイポーラ IC

キーワード				
ポリシリコン抵抗	ポリシリコン	キャパシタンス	寄生 PNP	VBO+40V
PolySi Resistance	PolySi Capacitance	Vertical NPN	Latelal PNP	VBO-40V
バッチカル NPN	Analog high end	バイポーラ IC	ラテラルPNP	

TVS

キーワード			
超低容量	ESD対策	雷誘導サージ	サージ保護
双方向	単方向	超小型パッケージ	1006 0603
高速通信	信号 歪み	極小チップ	SOD-923

IGBT

キーワード				
フィールドストップ	FS-IGBT	逆導通 IGBT	RC-IGBT	WSI
ノンパンチスルー	NPT-IGBT	タングステン プラグ	シリサイド	W-Plug

MOSFET

キーワード				
フィールドプレート	トレンチゲート	スプリットゲート	スーパー	ジャンクション
高速ダイオード	アバランシェ	保護ダイオード	モータードライブ	電源

バイポーラトランジスタ

キーワード			
標準半導体製品	高速スイッチ	低スイッチング損失	低導通損失
電流駆動	低VCE(sat)	高hFE	ダーリントン

ショットキーダイオード

キーワード			
二次側整流器	低VF	低I _r	DC DC コンバータ
ショットキーバリア	ダイオード	同期整流	力率改善回路

スイッチングダイオード

キーワード			
ファストリカバリ	高速 trr	低 I _{rr}	I _o VRSM
樹脂モールド	ガラスパッケージ	スイッチング	ダイオード

製造技術

キーワード				
タイコ研削	高加速イオン注入	薄ウエハ化技術	レーザーアニール	裏面イオン注入

国内営業本部
海外営業本部

〒715-8602 岡山県井原市木之子町150番地
〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町93番地 KRP4号館

Tel:0866-62-4603
Tel:075-311-9020

Phenitec...Fast and focused!

<http://phenitec.co.jp/>